

บทที่ 5

อภิปรายและสรุปผล

บทนี้เป็นการอภิปรายและสรุปผลการศึกษาของงานวิจัยนี้ ประกอบด้วยการเตรียมพิล์มบางไทเทเนียมโดยออกไซด์เฟสอนาคต การเตรียมพิล์มน้ำงาไทเทเนียมโดยออกไซด์เจือในโครงเอนและสมบัติทางแสงและแบบพลังงานของพิล์มบางไทเทเนียมโดยออกไซด์เจือในโครงเอน ดังนี้

อภิปรายผล

1. การเตรียมพิล์มน้ำงาไทเทเนียมโดยออกไซด์เฟสอนาคต

1.1 ผลของอัตราไหลแก๊สออกซิเจน พิล์มน้ำงาไทเทเนียมโดยออกไซด์เคลือบบนแผ่นชิลิกอน โดยแปรค่าอัตราไหลแก๊สออกซิเจนในช่วง 5 sccm - 15 sccm พบว่า พิล์มน้ำงาที่เคลือบได้ในงานวิจัยนี้พบว่า หรือสีเขียวอ่อน โดยโครงสร้างผลึกและลักษณะพื้นผิวของพิล์มที่เคลือบได้ในงานวิจัยนี้พบว่าเปลี่ยนแปลงไปตามตามอัตราไหลแก๊สออกซิเจน ดังนี้

โครงสร้างผลึกของพิล์ม จากรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของพิล์มน้ำงาไทเทเนียมโดยออกไซด์ที่เคลือบได้ เมื่อแปรค่าอัตราไหลแก๊สออกซิเจนที่ใช้ในกระบวนการเคลือบ พบว่าพิล์มที่เคลือบได้ทุกเงื่อนไขมีเฟสอนาคตระยะ (101) และเฟสอนาคตระยะ (200) โดยความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์เฟสอนาคตระยะ (101) มีค่าเพิ่มขึ้นตามอัตราไหลแก๊สออกซิเจน โดยที่อัตราไหลแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 15 sccm มีความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์สูงสุด ตามคลื่นกัมบานวิจัยของ Zeman and Takabayashi (2002) ซึ่งเคลือบพิล์มน้ำงาไทเทเนียมโดยออกไซด์ด้วยวิธีสปิตเตอริงแล้วพบว่าความดันย่อยแก๊สออกซิเจนซึ่งคุณด้วยการแปรค่าอัตราไหลแก๊สออกซิเจนมีผลต่อโครงสร้างของพิล์ม คือ เมื่อความดันย่อยแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของพิล์มน้ำงาไทเทเนียมโดยออกไซด์ที่เคลือบได้ซึ่งมีเฟสอนาคตระยะ (101) มีค่าเพิ่มขึ้น

สำหรับค่าคงที่แลตทิซของพิล์มที่เคลือบได้พบว่า เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราไหลแก๊สออกซิเจน โดยมีค่า a อุปในช่วง 3.784 Å – 3.785 Å ส่วนค่า c มีค่าอุปในช่วง 9.365 Å – 9.534 Å ซึ่งใกล้เคียงค่ามาตรฐาน ตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 89-4921 ของสารประกอบไทเทเนียมโดยออกไซด์เฟสอนาคต ที่มีโครงสร้างผลึกแบบเตตราゴนอล ($a = 3.777$ Å และ $c = 9.501$ Å)

ขนาดผลึกของฟิล์มที่เคลือบได้ คำนวณจากสมการของ Seherrer พบว่าขนาดผลึก มีค่าเพิ่มขึ้นตามอัตราไหลแก๊สออกซิเจน โดยที่อัตราไหลแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 5 sccm ผลึกมีขนาด เท่ากับ 54.28 nm เมื่ออัตราไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นเป็น 10 sccm ผลึกมีขนาดเพิ่มเป็น 56.15 nm สูดห้ายที่อัตราไหลแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 15 sccm ผลึกมีค่ามากที่สุดเท่ากับ 65.14 nm แสดงถึง กับงานวิจัยของ Zeman and Takabayashi (2002) ที่เคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุ่นไชด์ด้วย วิธีสปัตเตอริง แล้วพบว่า เมื่ออัตราไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้น ผลึกของฟิล์มบางไทเทเนียม โดยอุ่นไชด์ที่เคลือบได้มีขนาดใหญ่ขึ้น

ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มที่เคลือบได้ พบร่วมกับขนาดของฟิล์มเปลี่ยนแปลงไป ตามอัตราไหลแก๊สออกซิเจนที่เพิ่มขึ้น โดยฟิล์มที่เคลือบด้วยอัตราไหลแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 5 sccm และ 10 sccm เกรนมีลักษณะเล็กແล็ก และเมื่ออัตราไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นเป็น 15 sccm เกรนเริ่มมีขนาดใหญ่ เรียว และแหลมขึ้น แสดงถึงกับงานวิจัยของ อุดิตร บูรณวงศ์ (2551) ที่เคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุ่นไชด์ด้วยวิธีสปัตเตอริงแล้วพบว่า เมื่ออัตราไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้น ฟิล์มนี้เกรนโตขึ้น แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของ Tokuy et al. (2008) ที่ศึกษา ผลของอัตราไหลแก๊สออกซิเจนต่อลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุ่นไชด์ที่เคลือบด้วย วิธีสปัตเตอริง แล้วพบว่า เมื่อความดันย่อยแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้น ขนาดเกรนของฟิล์มเล็กลง

ความหนาของฟิล์มที่เคลือบได้ พบร่วมเมื่ออัตราไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นความหนา ของฟิล์มนี้ค่าลดลงจาก 238 nm เป็น 215 nm แสดงถึงกับงานวิจัยของ Hunsche, Vergohl, and Ritz (2005) ซึ่งพบว่าความหนาฟิล์มนี้ค่าลดลงตามความดันย่อยแก๊สออกซิเจนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก เมื่อปริมาณของแก๊สออกซิเจนในระบบมีค่าเพิ่มขึ้นตามอัตราไหลแก๊สออกซิเจนนี้ ส่งผลให้ อัตราการสปัตเตอร์ของปืนสารเคลือบลดลง เนื่องจากเมื่อแก๊สออกซิเจนมีปริมาณมาก อาจทำให้ เกิดสารประกลบออกไชด์ที่หน้าปืนสารเคลือบ เป็นผลให้ปืนสารเคลือบถูกสปัตเตอร์ได้ยากขึ้น ส่งผลให้อะตอนของไทเทเนียมที่จะทำปฏิกิริยา กับแก๊สออกซิเจน แล้วฟอร์มตัวเป็นชั้นฟิล์มบาง เคลือบบนผิวสัมผัสรองรับน้ำอย่างดี ปืนผลให้ฟิล์มนี้ความหนาลดลง

สำหรับความหนาผิวของฟิล์มที่เคลือบได้ พบร่วมเมื่ออัตราไหลแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้น ความหนาผิวนี้ค่าลดลงจาก 5.92 nm เป็น 4.85 nm แสดงถึงกับงานวิจัยของ Tokuy et al. (2008) ที่ศึกษาผลของความดันย่อยแก๊สออกซิเจนต่อลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุ่นไชด์ ที่เคลือบด้วยวิธีสปัตเตอริง แล้วพบว่า เมื่อความดันย่อยแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้น ความหนาผิวของ ฟิล์มนี้ค่าลดลง เนื่องจากเมื่อความดันย่อยแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้น สารเคลือบที่ตกเคลือบลงบนวัสดุ รองรับจะมีความบริสุทธิ์มากขึ้น ส่งผลให้พื้นผิวของฟิล์มนี้ความสม่ำเสมอและความหนาผิวลดลง

1.2 ผลของความดันรวม พิล์มนางไทเทเนียม ไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นซิลิกอน โดยแปรค่าความดันรวมในช่วง 3×10^{-3} mbar - 5×10^{-3} mbar พบว่า พิล์มที่เคลือบได้มีสีม่วงอ่อน และสีเขียวอมฟ้า โดยโครงสร้างผลึกและลักษณะพื้นผิวของพิล์มที่เคลือบ ได้เปลี่ยนแปลงไปตามความดันรวม ดังนี้

โครงสร้างผลึกของพิล์ม จากรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของพิล์มนางไทเทเนียม ไดออกไซด์ที่เคลือบบนแผ่นซิลิกอน เมื่อแปรค่าความดันรวมที่ใช้ในกระบวนการเคลือบ พบว่า เมื่อความดันรวมเพิ่มขึ้น โครงสร้างผลึกของพิล์มที่เคลือบ ได้จะเปลี่ยนไป โดยที่ความดันรวมต่ำ (3×10^{-3} mbar) พิล์มที่เคลือบได้มีเฉพาะเฟสรูไกล์ เมื่อความดันรวมเพิ่มขึ้นเป็น 5×10^{-3} mbar พบว่า โครงสร้างผลึกของพิล์มที่เคลือบ ได้เป็นเฟสผสมของรูไกล์/อนาเทส สุกด้วยที่ความดันรวมสูง (7×10^{-3} mbar และ 9×10^{-3} mbar) พิล์มที่เคลือบได้มีเฉพาะเฟสอนาคต สองคล้องกับงานวิจัยของ Yamagishi et al. (2003) ที่อธิบายถึงผลของการความดันรวมที่มีต่อ โครงสร้างผลึกของพิล์มนางไทเทเนียม ไดออกไซด์ว่า เมื่อความดันรวมเพิ่มขึ้นจะทำให้พิล์มนางไทเทเนียม ไดออกไซด์ด้วยความดันรวมต่ำแล้ว ได้เฟสแบบรูไกล์นั้น Yamagishi et al. (2003) ได้อธิบายว่า ที่ความดันรวมต่ำ ระยะปลดการชนเฉลี่ยมค่อนข้างมาก ทำให้อะตอมสารเคลือบ (ไทเทเนียม) หรืออนุภาคของแก๊ส ที่มีพลังงานสูงสามารถเคลื่อนที่ไปยังวัสดุรองรับ โดยปราศจากการชนกันทำให้อะตอมสารเคลือบมีพลังงานมากพอในการฟอร์มตัวเป็นไทเทเนียม ไดออกไซด์เฟสรูไกล์ ซึ่งต้องใช้พลังงานสูงในการฟอร์มตัว ล่างลงให้การจัดเรียงตัวของอะตอมไทเทเนียม ไดออกไซด์ที่เคลือบได้มีเฟสรูไกล์

สำหรับค่าคงที่แลดทิชของพิล์มที่เคลือบ ได้ พบว่าเปลี่ยนไปตามความดันรวม โดยมีค่า a อุบัติในช่วง $3.780 \text{ \AA} - 3.784 \text{ \AA}$ ส่วนค่า c มีค่าอยู่ในช่วง $9.446 \text{ \AA} - 9.485 \text{ \AA}$ ใกล้เคียงค่ามาตรฐานตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 89-4921 ของสารประกอบไทเทเนียม ไดออกไซด์เฟสอนาคต ที่มีโครงสร้างผลึกแบบเตตราゴนอล ($a = 3.777 \text{ \AA}$ และ $c = 9.501 \text{ \AA}$)

ขนาดผลึกของพิล์มที่เคลือบ ได้ คำนวณจากสมการของ Seherrter e พบว่าขนาดผลึกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยที่ความดันรวมเท่ากับ 3×10^{-3} mbar พิล์มมีเฟสรูไกล์ ผลึกมีขนาดเท่ากับ 17.21 nm เมื่อความดันรวมเพิ่มขึ้นเป็น 5×10^{-3} mbar พิล์มมีเฟสผสมของรูไกล์/อนาเทส ผลึกมีขนาดเพิ่มเป็น 58.16 nm สุดท้ายที่ความดันรวมเท่ากับ 7×10^{-3} mbar และ 9×10^{-3} mbar พิล์มมีเฟสอนาคต ผลึกมีค่าเท่ากับ 49.35 nm และ 50.89 nm ตามลำดับ

ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มที่เคลือบได้พบว่า ลักษณะกรนของฟิล์มเปลี่ยนไปตามความดันรวมที่เพิ่มขึ้น โดยฟิล์มที่เคลือบด้วยความดันรวมเท่ากับ 3×10^{-3} mbar เกรนมีลักษณะเล็กกลมมน เมื่อความดันรวมเพิ่มเป็น 5×10^{-3} mbar, 7×10^{-3} mbar และ 9×10^{-3} mbar เกรนเริ่มมีขนาดเล็ก เรียวและแหลมขึ้น สาเหตุที่ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มที่เคลือบได้เปลี่ยนแปลงไปนั้นเป็นผลมาจากการผลัจงานของสารเคลือบ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ Zhou et al. (2006) ที่เคลือบฟิล์มไทเทเนียมโดยอุ่นไชด์ด้วยวิธีสปัตเตอริง อธิบายว่าพลัจงานในการเคลือบมีผลกระทบต่อขนาดเกรน ซึ่งหากพลัจงานในการเคลือบมาก ทำให้สามารถฟอร์มตัวเป็นฟิล์มได้ดีและมีขนาดเกรนใหญ่

ความหนาของฟิล์ม พบว่าเมื่อความดันรวมเพิ่มขึ้น ฟิล์มที่เคลือบได้มีความหนาเพิ่มขึ้นจาก 190 nm เป็น 220 nm เนื่องจากที่ความดันรวมสูง ปริมาณของแก๊สอาร์กอนในห้องเคลือบมีจำนวนมาก ส่งผลให้ออกนของแก๊สอาร์กอนสามารถสปัตเตอร์อะตอมของไทเทเนียมออกมายในปริมาณสูง และรวมตัวกับแก๊สออกซิเจนเป็นสารประกอบของฟิล์มตกลงเคลือบบนวัสดุรองรับได้มาก ทำให้ฟิล์มที่เคลือบได้มีความหนานมากขึ้น แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของ Sirghi, Aoki, and Hatanaka (2002) ซึ่งพบว่าความดันรวมเพิ่มขึ้น อัตราเคลือบมีค่าลดลง ส่งผลให้ความหนาของฟิล์มลดลง เนื่องจากอัตราเคลือบขึ้นกับอัตราการสปัตเตอริงและความน่าจะเป็นของ การชนแบบกระเจิง (Scattering Collisions) ของสปัตเตอร์อะตอมกับอะตอมของแก๊สที่อยู่รอบ ๆ

ความหนาผิวของฟิล์ม พบว่าเมื่อความดันรวมเพิ่มขึ้น ความหนาผิวของฟิล์มที่ได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยที่ความดันรวมเท่ากับ 5.0×10^{-3} mbar มีค่าความหนาผิวสูงสุดเท่ากับ 5.9 nm เนื่องจากฟิล์มที่เคลือบได้เป็นเฟสสมของรูไทร์/อนาคต ลักษณะกรนของฟิล์มเป็นแบบแหลมสูง และหลุมลึกขนาดต่าง ๆ ทำให้ผิวน้ำของฟิล์มมีลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ แตกต่างกันมาก ส่งผลโดยตรงต่อกำลังของฟิล์มที่เคลือบ สำหรับความดันรวมเท่ากับ 3.0×10^{-3} mbar ฟิล์มที่ได้เป็นเฟสรูไทร์ และที่ความดันรวมเท่ากับ 7.0×10^{-3} mbar และ 9.0×10^{-3} mbar ฟิล์มที่เคลือบได้เป็นเฟสอนาคต โดยโครงสร้างหลักของฟิล์มแต่ละแบบนั้นมีผลต่อค่าความหนาผิวของฟิล์มที่เคลือบได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Li et al. (2006) ที่อธิบายผลของการดันรวมต่อความหนาผิวของฟิล์มไทเทเนียมโดยอุ่นไชด์ว่าเมื่อความดันรวมเพิ่มขึ้นจะทำให้ฟิล์มบาง ไทเทเนียมโดยอุ่นไชด์มีค่าความหนาผิวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อความดันรวมมีค่าเพิ่มขึ้นจะทำให้ความน่าจะเป็นในการชนกันของอนุภาคสารเคลือบเพิ่มขึ้น แต่ทำให้พลัจงานของอนุภาคสารเคลือบลดลง ส่งผลให้ค่าความสามารถในการเคลือบเพิ่มขึ้น แต่ทำให้พลัจงานของอนุภาคสารเคลือบและ Adatom บนวัสดุรองรับมีค่าลดลง จนความหนาผิวมีค่าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

2. การเตรียมฟิล์มบางไทเทนเนียมโดยออกไซด์เจือในไตรเจน

ฟิล์มบางไทเทนเนียมโดยออกไซด์เจือในไตรเจนเคลือบบนแผ่นซิลิกอน โดยแบรค่า อัตราไหเดแก๊สในไตรเจนอยู่ในช่วง 1 sccm - 3 sccm พบรวม ฟิล์มบางที่เคลือบได้มีลักษณะใส สั่งผ่านแสง มีสีเขียวจาง ๆ โดยโครงสร้างผลึกและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มที่เคลือบได้เปลี่ยน ตามอัตราไหเดแก๊สในไตรเจน ดังนี้

โครงสร้างผลึกของฟิล์ม จากรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มที่เคลือบได้ บนแผ่นซิลิกอน พบรวมฟิล์มที่เคลือบเมื่อไหเดในไตรเจนมีเพสผสนของอนาเทสและรูไอล์ เตตเมื่อไหเดในไตรเจนในกระบวนการเคลือบโดยการเพิ่มอัตราไหเดแก๊สในไตรเจนตั้งแต่ 1 sccm ถึง 3 sccm ฟิล์มที่เคลือบได้ยังคงมีรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์เหมือนฟิล์มชุดที่ไม่ได้ไหเดในไตรเจน กล่าวคือมุม 20 ของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังคงเท่าเดิมคือ 25.34° , 27.28° และ 47.98° เตตความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ลดลงทุกระนาบ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ Hernández-Rodríguez et al. (2008) ที่อธิบายผลของการอัตราไหเดแก๊สในไตรเจนที่มีต่อ โครงสร้างผลึกของฟิล์มไทเทนเนียมโดยออกไซด์เจือในไตรเจนว่า เมื่ออัตราไหเดแก๊สในไตรเจน เพิ่มขึ้นฟิล์มที่เคลือบได้ยังคงมีโครงสร้างผลึกเป็นแบบอนาเทสไม่เปลี่ยนแปลง ไปตามอัตราไหเด แก๊สในไตรเจน

ค่าคงที่แลดทิชของฟิล์มที่เคลือบได้เปลี่ยนไปตามอัตราไหเดแก๊สในไตรเจน โดยมีค่า a อยู่ในช่วง 3.780 \AA - 3.784 \AA ส่วนค่า c มีค่าอยู่ในช่วง 9.446 \AA – 9.485 \AA ซึ่งใกล้เคียงค่า มาตรฐานตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 89-4921 ของสารประกอบไทเทนเนียมโดยออกไซด์ เฟสอนาคต ที่มีโครงสร้างผลึกแบบเตตราゴโนลด ($a = 3.777 \text{ \AA}$ และ $c = 9.501 \text{ \AA}$)

ขนาดผลึกของฟิล์มที่เคลือบได้คำนวณจากสมการของ Seherrer พบรวมขนาดผลึก ของฟิล์มที่ไม่ไหเดในไตรเจนมีขนาดเท่ากับ 50.88 nm เมื่อไหเดในไตรเจนในกระบวนการเคลือบด้วย อัตราไหเดแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 1 sccm ผลึกมีขนาดลดลงเป็น 31.36 nm และสุดท้ายเมื่ออัตราไหเด แก๊สในไตรเจนเท่ากับ 2 sccm และ 3 sccm ผลึกมีขนาดเท่ากับ 30.72 nm และ 27.14 nm ตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chui et al. (2007) ซึ่งพบว่าเมื่ออัตราไหเดแก๊สในไตรเจนที่ใช้เจือใน กระบวนการเคลือบฟิล์มบางไทเทนเนียมโดยออกไซด์เพิ่มขึ้น ฟิล์มที่เคลือบได้มีขนาดผลึกลดลง เนื่องจากไนโตรเจนที่เจือในกระบวนการเคลือบจะไปลดความสามารถในการเคลือบ (Mobility) ของอะตอมไทเทนเนียมและออกซิเจนซึ่งส่งผลต่อการเกิดนิวเคลียชัน (Nucleation) ของสารเคลือบ ที่จะฟอร์มตัวเป็นฟิล์มไทเทนเนียมโดยออกไซด์เจือในไตรเจนในที่สุด (Hukaru et al., 2002; Mohamed et al., 2004)

ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มที่เคลือบได้พบว่าลักษณะเกรนของฟิล์มเปลี่ยนไปตามอัตราไหลแก๊สในไตรเจน โดยฟิล์มที่เคลือบเมื่อไม่เจือไนไตรเจน พบว่าเกรนมีขนาดใหญ่และเรียวยาวแต่เมื่อเจือไนไตรเจนในกระบวนการเคลือบฟิล์มด้วยอัตราไหลแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 1 sccm, 2 sccm และ 3 sccm เกรนของฟิล์มเริ่มจับกลุ่มกันเป็นก้อนและมีขนาดเล็ก ซึ่งต่างกับงานวิจัยของ Chui et al. (2007) ที่พบว่าฟิล์มไทยเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบเมื่อไม่เจือไนไตรเจนเกรนของฟิล์มมีลักษณะเป็นก้อนกลม (Small Round-Shape Nodules) แต่เมื่อเจือไนไตรเจนในกระบวนการเคลือบพบว่า เกรนของฟิล์มมีลักษณะเป็นก้อนแหลม (Acute Angle-Shape Nodules)

ความหนาของฟิล์มที่เคลือบได้พบว่าเมื่ออัตราไหลแก๊สในไตรเจนในกระบวนการเคลือบเพิ่มขึ้น ฟิล์มที่เคลือบได้มีความหนาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยเพิ่มขึ้นจาก 225 nm เป็น 236 nm เนื่องจากเมื่อปริมาณแก๊สในไตรเจนในระบบเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้แก๊สในไตรเจนสามารถรวมตัวกับตะตอบไทยเนียมและแก๊สออกซิเจนเป็นสารเคลือบและตกเคลือบนนวัสดุรองรับได้มาก ซึ่งทำให้ฟิล์มที่เคลือบได้มีความหนามากขึ้น ส่วนความหมายพิวของฟิล์มที่เคลือบได้พบว่า เมื่ออัตราไหลแก๊สในไตรเจนในกระบวนการเคลือบเพิ่มขึ้น ความหมายพิวมีค่าอยู่ในช่วง 4.1 nm - 5.4 nm

3. สมบัติทางแสงและแบบพัธยานของฟิล์มบางไทยเนียมไดออกไซด์เจือไนไตรเจน

ฟิล์มบางไทยเนียมไดออกไซด์เจือไนไตรเจนเคลือบนกระจกสไลด์ เมื่อประกบอัตราไหลแก๊สในไตรเจนอยู่ในช่วง 1 sccm - 3 sccm โดยสรุปพบว่าอัตราไหลแก๊สในไตรเจน มีผลต่อสมบัติทางแสงและแทนพลังงานของฟิล์ม ดังนี้

ค่าการส่งผ่านแสง พบว่าฟิล์มที่เคลือบได้ทั้งหมดสามารถส่งผ่านแสงได้ดีในช่วงตากองเห็นและอินฟราเรดไกล (ความยาวคลื่นในช่วง 300 – 2500 nm) โดยมีค่าการส่งผ่านแสงสูงตลอดความยาวคลื่นที่พิจารณา ทั้งนี้หากพิจารณาเป็นการส่งผ่านแสงของฟิล์มบางไทยเนียมไดออกไซด์เจือไนไตรเจนที่เคลือบได้ทั้งหมดพบว่ามีลักษณะคล้ายการกระเพื่อมของคลื่นกล่าวคือ มีค่าเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกันตลอดความยาวคลื่นแสงที่พิจารณา เนื่องจากการแทรกสอดของแสงผ่านชั้นของฟิล์มบางไทยเนียมไดออกไซด์เจือไนไตรเจนที่เคลือบนแผ่นกระจกสไลด์นั้นเอง

ค่าดัชนีหักเหและสัมประสิทธิ์การดับสูญของฟิล์มที่ได้จากวิธี Envelope โดยใช้ข้อมูลจากสเปกตรัมการส่งผ่านแสงมาคำนวณ พบว่าที่ความยาวคลื่นแสงเท่ากับ 550 nm ฟิล์มที่เคลือบได้เมื่อไม่เจือไนไตรเจนมีค่าดัชนีหักเหเท่ากับ 2.61 และมีค่าลดลงเป็น 2.53 สำหรับฟิล์มที่เคลือบได้เมื่อเจือไนไตรเจนในช่วง 1 sccm - 3 sccm ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wu, Ma, and Shang (2004) ที่ศึกษาผลการเจือไนไตรเจนต่อสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไทยเนียมไดออกไซด์แล้วพบว่าค่าดัชนีหักเหของฟิล์มที่เจือไนไตรเจน มีค่าลดลง เมื่ออัตราไหลแก๊สในไตรเจนในการเจือ

เพิ่มขึ้น ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การดับสูญของฟิล์มที่เคลือบได้ พบว่าสำหรับฟิล์มชุดที่ไม่เจือในไตรเจน สัมประสิทธิ์การดับสูญมีค่าเท่ากับ 0.001 ซึ่งใกล้เคียงศูนย์แสดงให้เห็นว่าฟิล์มที่เคลือบได้มีการดูดกลืนตัวจึงมีลักษณะใสส่องผ่านแสงได้ดี ขณะที่ฟิล์มชุดที่เคลือบโดยมีการเจือในไตรเจน ในกระบวนการเคลือบฟิล์มด้วยอัตราไหลแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 1 sccm ถึง 3 sccm พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การดับสูญมีค่าในช่วง $0.001\text{-}0.002$ ใกล้เคียงฟิล์มชุดที่ไม่เจือในไตรเจน

สำหรับค่าແຄນพลังงานของฟิล์มบางที่เคลือบได้ มีค่าเท่ากับจุดตัดบน แกน x ของ กราฟระหว่าง $(ahv)^{1/2}$ กับ hv (Chiu et al., 2007) พบว่าฟิล์มชุดที่เคลือบได้เมื่อไม่เจือในไตรเจน มีค่าແຄນพลังงานเท่ากับ 3.10 eV ใกล้เคียงค่าແຄນพลังงานของฟิล์มบาง ไทเทเนียม ไดออกไซด์ เฟสอนาคต สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ฟิล์มที่เคลือบได้ในงานวิจัยนี้ด้วยเทคนิค XRD ซึ่งพบว่า ฟิล์มที่เคลือบได้ชุดนี้เป็นฟิล์มบาง ไทเทเนียม ไดออกไซด์เฟสอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ Luca et al. (2007) ซึ่งเคลือบฟิล์ม ไทเทเนียม ไดออกไซด์แบบ ไม่เจือ ในไตรเจนแล้ว ได้เฟสอนาคต ซึ่งมีค่าແຄນพลังงานเท่ากับ 3.09 eV ขณะที่ฟิล์มที่เคลือบได้ในงานวิจัยนี้ เมื่อมีการเจือในไตรเจน ในกระบวนการเคลือบ ด้วยอัตราไหลแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 1 sccm ถึง 3 sccm พบว่าฟิล์มที่เคลือบได้ชุดนี้ มีค่าແຄນพลังงาน 2 ค่า คือ (1) มีค่าແຄນพลังงานเท่ากับ 3.20 eV ซึ่งเท่ากับค่าແຄນพลังงาน ของฟิล์มบาง ไทเทเนียม ไดออกไซด์เฟสอนาคต (ແຄນพลังงาน = 3.20 eV) (Herman et al., 2006) และ (2) มีค่าແຄນพลังงานประมาณ 2.50 eV ซึ่งมีค่าต่ำกว่าค่าແຄນพลังงานของฟิล์มบาง ไทเทเนียม ไดออกไซด์เฟสอนาคต และมีค่าลดลงเมื่ออัตราไหลแก๊สในไตรเจนที่เจือในกระบวนการเคลือบ มีค่าเพิ่มขึ้น โดยແຄນพลังงานของฟิล์มที่เคลือบได้ในงานวิจัยนี้ มีค่าลดลงจาก 2.60 eV เป็น 2.40 eV สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hernández-Rodríguez et al. (2008) ที่พบว่า เมื่อเจือในไตรเจนในฟิล์ม บาง ไทเทเนียม ไดออกไซด์แล้วจะทำให้ค่าແຄນพลังงานของฟิล์มเปลี่ยนไป กล่าวคือ มีค่าลดลงจาก 3.50 eV เป็น 2.70 eV ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ โดยปกติแล้ว ແຄນการนำ (Conduction Bands) และ ແຄນวาเลนซ์ (Valence Bands) ของ ไทเทเนียม ไดออกไซด์ ประกอบขึ้นจาก ออร์บิทัล (Orbital) ของ ไทเทเนียม $3d$ และ ออกซิเจน $2p$ และเนื่องจาก ออร์บิทัล $2p$ ของ ไตรเจน มี พลังงาน ศักย์มากกว่า ออร์บิทัล $2p$ ของ ออกซิเจน ดังนั้น การเพิ่มจำนวนอะตอม ใน ไตรเจน ใน ฟิล์ม ไทเทเนียม ไดออกไซด์ โดยการเจือ จึงเป็น การเพิ่ม พลังงาน ศักย์ลบ (Negative Potential Energy) ของ ແຄນวาเลนซ์ เมื่อเทียบ กับ ไทเทเนียม ไดออกไซด์ บริสุทธิ์ ซึ่งทำให้ค่าແຄນพลังงานของ ไทเทเนียม ไดออกไซด์ เจือ ใน ไตรเจน มีค่าແຄນพลังงาน ต่ำกว่า ไทเทเนียม ไดออกไซด์ บริสุทธิ์ (Asahi et al., 2001) ทั้งนี้จากการเปลี่ยน ค่าແຄນพลังงาน ของ ฟิล์ม ไทเทเนียม ไดออกไซด์ ที่ เคลือบ ได้ ใน งาน วิจัยนี้ เมื่อมี การเจือ ใน ไตรเจน ใน กระบวนการเคลือบ จาก 3.20 eV เป็น 2.50 eV จึงอาจกล่าวโดยสรุป ได้ว่า งาน วิจัยนี้ สามารถ กล่าวได้ว่า สำหรับ ฟิล์ม บาง ไทเทเนียม ไดออกไซด์ เจือ ใน ไตรเจน ได้สำเร็จ

สรุปผลการทดลอง

1. การเตรียมฟิล์มบางไทเทนเนียมโดยออกไซด์เฟสонаเทส

1.1 ผลของอัตราไหลดแก๊สออกซิเจน

- ฟิล์มบางไทเทนเนียมโดยออกไซด์ที่เคลือบได้มีสีม่วง และสีเขียวอ่อน
- โครงสร้างหลักของฟิล์มที่เคลือบได้ทุกเงื่อนไขมีเฟสอนาคตระนาบ (101) และ เฟสอนาคตระนาบ (200) โดยความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของเฟสอนาคตระนาบ (101) มีค่าเพิ่มขึ้นตามอัตราไหลดแก๊สออกซิเจนในกระบวนการการเคลือบ โดยที่อัตราไหลดแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 15 sccm มีความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์สูงสุด
- อัตราไหลดแก๊สออกซิเจนมีผลต่อความหนาและความหมายผิวของฟิล์มที่เคลือบได้ โดยเมื่ออัตราไหลดแก๊สออกซิเจนเพิ่มขึ้นความหนาและความหมายผิวของฟิล์มมีค่าลดลง จาก 238 nm เป็น 215 nm และ 5.92 nm เป็น 4.85 nm ตามลำดับ

1.2 ผลของความดันรวม

- ฟิล์มบางไทเทนเนียมโดยออกไซด์ที่เคลือบได้มีสีม่วงอ่อน และสีเขียวอมฟ้า
- โครงสร้างหลักของฟิล์มเปลี่ยนไปตามความดันรวม โดยที่ความดันรวมต่ำ ฟิล์มที่เคลือบได้มีเฉพาะเฟสรูไทร์แล็ป เมื่อความดันรวมเพิ่มสูงขึ้นฟิล์มเปลี่ยนเป็นเฟสผสมของรูไทร์/อนาคต และเป็นเฟสอนาคตในที่สุด
- ความดันรวมมีผลต่อความหนาและความหมายผิวของฟิล์มที่เคลือบได้ โดยเมื่อความดันรวมเพิ่มขึ้นความหนามีค่าเพิ่มขึ้นจาก 190 nm เป็น 220 nm ส่วนความหมายผิว มีค่าอยู่ในช่วง 2.2 nm - 5.9 nm

2. การเตรียมฟิล์มบางไทเทนเนียมโดยออกไซด์เจือในโทรเจน

2.1 ฟิล์มบางไทเทนเนียมโดยออกไซด์เจือในโทรเจนที่เคลือบได้มีลักษณะใส

สั่งผ่านแสง มีสีเขียวจาง ๆ

2.2 โครงสร้างหลัก ฟิล์มที่เคลือบเมื่อไม่เจือในโทรเจนมีเฟสผสมของรูไทร์/อนาคต แต่เมื่อเจือในโทรเจนในกระบวนการการเคลือบ ฟิล์มที่เคลือบได้ยังคงมีรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์เหมือนฟิล์มชุดที่ไม่เจือในโทรเจน และเมื่ออัตราไหลดแก๊สในโทรเจนเพิ่มขึ้นความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ลดลงทุกรายการ

2.3 อัตราไหลดแก๊สในโทรเจนมีผลต่อความหนาและความหมายผิวของฟิล์มบางที่เคลือบได้ โดยเมื่ออัตราไหลดแก๊สในโทรเจนเพิ่มขึ้นฟิล์มมีความหนาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 225 nm เป็น 236 nm ส่วนความหมายผิวของฟิล์มมีค่าอยู่ในช่วง 4.1 nm - 5.4 nm

3. สมบัติทางแสงและแบบพลังงานของฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุ่นไฮด์ร็อกเจือในโทรเรน

3.1 ฟิล์มที่เคลือบได้มีลักษณะใส สามารถส่องผ่านแสงได้ดีในช่วงตามองเห็นและอินฟราเรดไกล (ความยาวคลื่นในช่วง 300 – 2500 nm)

3.2 ดัชนีหักเหของฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุ่นไฮด์ร็อกเจือในโทรเรนที่เคลือบได้พิจารณาที่ความยาวคลื่นแสงเท่ากับ 550 nm พบว่าฟิล์มมีค่าดัชนีหักเหเท่ากับ 2.61 และมีค่าลดลงเป็น 2.53 เมื่อเจือในโทรเรนในกระบวนการเคลือบ

3.3 ค่าสัมประสิทธิ์การดับสูญของของฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุ่นไฮด์ร็อกเจือในโทรเรนที่เคลือบได้ พิจารณาที่ความยาวคลื่นแสงเท่ากับ 550 nm พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.001 และฟิล์มชุดที่เคลือบได้มีการเจือในโทรเรนมีค่าสัมประสิทธิ์การดับสูญอยู่ในช่วง 0.001 – 0.002 พบว่า ใกล้เคียงฟิล์มชุดที่ไม่เจือในโทรเรน

3.4 แอนพลังงาน (E_g) ของฟิล์มที่เคลือบได้มีอยู่ในโทรเรนนี้ค่าเท่ากับ 3.10 eV ขณะที่ฟิล์มที่เคลือบได้มีการเจือในโทรเรนมีแอนพลังงาน 2 ค่า คือ (1) มีค่าเท่ากับ 3.20 eV และ (2) มีค่าประมาณ 2.50 eV และมีค่าลดลงเมื่ออัตราไหლแก๊สในโทรเรนที่เจือในกระบวนการเคลือบ มีค่าเพิ่มขึ้น โดยมีค่าลดลงจาก 2.60 eV เป็น 2.40 eV แสดงว่า งานวิจัยนี้สามารถเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมโดยอุ่นไฮด์ร็อกเจือในโทรเรนได้สำเร็จ